水素雰囲気異方性熱エッチング(HEATE)法で作製した InGaN/GaN ナノ構造のオゾン水パッシベーション

Passivation effect of ozone water treatment on InGaN/GaN nanostructures fabricated by hydrogen environment anisotropic thermal etching (HEATE)

上智大・理工¹, 上智大ナノテクセンター² ⁰小川 航平¹, 水谷 友哉¹, 石嶋 駿¹, 生江 祐介¹, 松岡 明裕¹, 菊池 昭彦^{1,2} Sophia Univ.¹, Sophia Nanotechnology Research Center,² ^oKohei Ogawa¹, Tomoya Mizutani¹, Shun Ishijima¹, Yusuke Namae¹, Akihiro Matsuoka¹, Akihiko Kikuchi^{1,2} E-mail: kikuchi@sophia.ac.jp

はじめに:InGaN/GaN量子井戸を内在するナノ 構造は、歪緩和効果や貫通転位隔離効果、量子 効果、光取出効率の向上などによる発光特性の 向上をもたらす魅力的な材料である。しかし、 ナノ構造はその微細化に伴って体積に対する 表面積の割合が増大して表面非発光再結合の 影響が顕在化する。このため、表面パッシベー ションは、ナノ構造デバイスの高性能化におい て重要な技術である。我々は、高温(1000℃近 傍)水素雰囲気中におけるGaNの熱分解反応を 利用する低損傷エッチング技術(水素雰囲気異 方性熱エッチング: HEATE法)を提案し、 InGaN/GaN系ナノ構造の作製と評価を行って きた。^[1] 今回は、HEATE法で作製した InGaN/GaNナノピラー構造に対する飽和オゾ ン水(SOW: saturated ozone water)を用いたパッシベ ーション効果を室温PL(RT-PL)と時間分解 PL(TR-PL)を用いて検討したので報告する。

実験: サファイア基板 (PSS) 上にMOCVD法で p-GaN と n-GaN/n-AlGaN に挟まれた6周期の InGaN/GaN 多重量子井戸 (MQW)青色LEDを成 長したエピウェハ上に、PECVD法で厚さ100 nm のSiO₂ナノマスクを形成した。この試料を石英 管炉内で水素圧力10 Pa、温度1050 ℃で10 min 間加熱してInGaN/GaNナノピラー構造を作製 した。バッファードフッ酸(BHF)で試料の表面 自然酸化膜除去(BOE)を行った後、室温ホトル ミネッセンス(RT-PL)と室温時間分解PL(TR-PL)測定を行った。励起光にはHe-Cdレーザ(波 長325 nm)とInGaNパルスレーザ(波長375 nm) をそれぞれ用いた。次に、試料をSOWに5、30、

120 min間浸けた後にも同様の測定を行った。 結果:試料には周期200 nmの三角格子状に配列 したInGaN直径(対辺間距離)が42 nmと79 nmの ナノピラーアレイを用いた。Fig.1にInGaN直径 42 nmのナノピラー構造におけるBOE処理と SOW処理後のPL減衰曲線を示す。BOE処理後 の発光寿命時間0.65 nsecに対し、5、30 min間の SOW処理後には発光寿命が1.0 nsec、1.9 nsecと それぞれ増加し、120 minでは飽和した。Fig.2 にInGaN直径79nmのナノピラー構造のBOE処 理後と30 minのSOW処理後の室温PLスペクト ルを示す。30 minのSOW処理によってピーク波 長が435 nmから428 nmシフトし、ピーク強度が 80%増加した。これはSOW処理によってナノピラー表面にGa2O3などの酸化被膜が形成され、 表面非発光再結合を抑制するパシベーション 効果が現れたためと考えられる。ピーク波長の シフトは、酸化被膜による内部応力の変化に起 因すると考えられる。

まとめ:飽和オゾン水によるInGaN/GaNナノ構造のパシベーション効果について検討し、室温発光寿命の増加、PLピーク強度の増加を確認した。

謝辞:日頃ご支援いただく上智大学岸野克巳教授に感 謝します。本研究の一部は科研費助成事業 挑戦的萌芽 研究16K14260の援助を受けて行われた。

参考文献: [1] R. Kita, R. Hachiya, T. Mizutani, H. Furuhashi and A. Kikuchi, Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 046501.



Fig.1 RT-PL decay curves of MQW nanopillars with InGaN diameter of 42 nm after BOE and SOW treatment



Fig.2 The PL spectrum after BOE treatment and 30 min SOW treatment.